Сведения о ведущей организации

Полное и сокращенное название организации:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова (ИФП СО РАН)
Сибирского отделения Российской академии наук
Место нахождения: г. Новосибирск, Российская Федерация

- Почтовый адрес: 630090, Россия, Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 13
- Телефон: +7(383)330-90-55
- E-mail: ifp@isp.nsc.ru

Официальный сайт: http://www.isp.nsc.ru

Список публикаций сотрудников ИФП СО РАН по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях:

1. Ф.А.Кузнецов, М.Г.Воронков, В.О.Борисов, И.К.Игуменов, В.В.Каичев, В.Г.Кеслер, В.В.Кириенко, В.Н.Кичай, М.Л.Косинова, В.В.Кривенцев, М.С.Лебедев, А.В.Лис, Н.Б.Морозова, Л.Д.Никулина, В.И.Рахлин, Ю.М.Румянцев, Т.П.Смирнова, В.С.Суляева, С.В.Сысоев, А.А.Титов, Н.И.Файнер, И.П.Цырендоржиева, Л.И.Чернявский, Л.В.Яковкина.// Фундаментальные основы процессов химического осаждения пленок и структур для наноэлектроники, Серия «Интеграционные проекты СО РАН» , Под ред. Т.П.Смирновой. 2013, Новосибирск: Издательство СО РАН, 175 стр.
2. A.I. Nikiforov, V.A. Timofeev, S.A. Teys, A.K. Gutakovsky, O.P. Pchelyakov. Ge and GexSi1−x islands formation on GexSi1−x solid solution surface. // Thin Solid Films, 2012, v.520, №8, p.3319-3321.
3. A.I.Nikiforov, V.A.Timofeev, S.A.Teys, A.K.Gutakovsky, O.P.Pchelyakov. nitial stage growth of Ge_xSi_{1-x} layers and Ge quantum dot formation on Ge_xSi_{1-x} surface by MBE. // Nanoscale Research Letters, 2012, vol.7, №1, p.561.
4. A.D.Rodrigues, A.J.Chiquito, G.Zanelatto, A.G.Milekhin, A.I.Nikiforov, V.V.Ulyanov, O.P.Pchelyakov, D.R.T.Zahn, J.C.Galzerani. Ge/Si Quantum dots superlattices grown at different temperatures and characterized by raman spectroscopy and capacitance veasurements. // Advances in Condensed Matter Physics,2012, vol.2012, №4, p.1-7.
5. V.A.Volodin, A.A.Popov, A.Misiuk, H.Rinnert, M.Vergnat. Evolution of Silicon and Hydrogen bonding in silicon-rich nitride films prepared by plasma-enhanced chemical vapor deposition and annealed under high pressure. // Nanoscience and Nanotechnology Letters, 2012, vol.4, №3, p.364-368.
6. А.И.Никифоров, В.И.Машанов, В.А.Тимофеев, С.А.Тийс, О.П.Пчеляков. Синтез гетероэпитаксиальных пленок $Si_xSn_yGe_{1-x-y}$ на Si(100). // Известия высших учебных заведений. Физика, 2013, т.56, №9/2, стр.116-118.
7. A.A. Shklyaev, K.N. Romanyuk, S.S. Kosolobov. Surface morphology of Ge layers epitaxially grown on bare and oxidized Si(001) and Si(111) substrates. // Surface Science, 2013, vol.625, p.50-56
8. A.I.Yakimov, V.V. Kirienko, V.A. Armbrister, A.V. Dvurechenskii. Hydrogen passivation of self-assembled Ge/Si quantum dots. // Semiconductor Science and Technology, 2014, vol .29, №8, p. 085011.
9. И.В. Антонова, С.В. Голод, Р.А. Соотс, А.И. Комонов, В.А. Селезнев, М.А. Сергеев, В.А. Володин, В.Я. Принц. Сравнение разных способов переноса графена и мультиграфена,

выращенных методом химического газофазного осаждения, на изолирующую подложку SiO_2/Si. // Физика и техника полупроводников, 2014, т.48, №6, стр.827-832.
10. Е.Н. Ермакова, В.Г. Кеслер, Ю.М. Румянцев, М.Л. Косинова. Исследование типов химических связей в плёнках, полученных плазмохимическим разложением паров бис (триметилсилил) этиламина. // Журнал структурной химии, 2014, т.55, №3, стр.486-492.
11. А.С. Ильин, Е.М. Труханов, С.А. Тийс, А.К. Гутаковский. Анализ дислокационной структуры в гетерогранице Ge/Si(111). // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2014, т.2014, №8, стр.58-64.
12. А.И. Никифоров, В.А. Тимофеев, С.А. Тийс, О.П. Пчеляков. Формирование наногетероструктур Ge/Si и Ge/Ge_xSi_{1-x}/Si методом молекулярно-лучевой эпитаксии. // Автометрия, 2014, т.50, №3, стр.5-12.
13. А.С. Паршин, Е.П. Пьяновская, О.П. Пчеляков, Ю.Л. Михлин, А.И. Никифоров, В.А. Тимофеев, М.Ю. Есин. Спектроскопия сечения неупругого рассеяния электронов твердых растворов Ge_xSi_{1-x}. Физика и техника полупроводников, 2014, т.48, №2, стр.237-241.
14. Nikiforov A.I., Timofeev V.F., Pchelyakov O.P. Surface structure of thin psevdomorphous GeSi layers. // Applied Surface Science, 2015, т. 354, с. 450-452.
15. Timofeev V.A., Nikiforov A.I., Zinovyev V.A., Teys S.A., Pchelyakov O.P. Formation of Ge/Si nanoscale structures at different growth conditions by molecular beam epitaxy.// Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2015, Vol. 10, № 1, p. 99-103.